

OBSAH

1 ÚVOD	5
1.1 FORMULACE PROBLÉMU	5
1.2 SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY	6
1.3 CÍLE DISERTACE	10
2 ZVOLENÉ METODY ZPRACOVÁNÍ	11
2.1 ZESÍLENÍ GOOSOVA-HÄNCHENOVÉ POSUVU	11
2.2 METODA SINGULÁRNÍHO SPEKTRÁLNÍHO INDEXU LOMU	12
2.3 EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ TLOUŠTKY VRSTVY	14
3 HLAVNÍ VÝSLEDKY PRÁCE	15
3.1 ZESÍLENÍ GOOSOVA-HÄNCHENOVÉ POSUVU PRO TE A TM MÓDY	15
3.2 METODA SINGULÁRNÍHO SPEKTRÁLNÍHO INDEXU LOMU	17
3.3 VLIV EXPERIMENTÁLNÍCH PARAMETRŮ MIKROSKOPU	19
3.3.1 <i>Vliv vzdálenosti hrot sondy – povrch vzorku</i>	19
3.3.2 <i>Měření tloušťky tenké dielektrické vrstvy</i>	20
4 ZÁVĚR	22
5 REFERENCE	24
6 VLASTNÍ PUBLIKACE	25
7 CURRICULUM VITAE	29
8 ABSTRACT	30